

型名	社名	用途	構造	チャンネル	最大定格					電気的特性 (Ta=25°C)														
					V***	区分***	Vgs*	区分*	I*	区分*	Pd/PCH	I _{gss} (max)	V _{GS}	I _{DSS} (min)	I _{DSS} (max)	V _{DS}	V _{GS(off)} (min)	V _{GS(off)} (max)	V _{DS}	I _D	I _D ^{gm} (min)	I _D ^{gm} (typ)	V _{DS}	I _D
					(V)		(V)		(A)		(W)	(A)	(V)	(A)	(A)	(V)	(V)	(V)	(A)	(S)	(S)	(V)	(A)	
2SK616	富士電機	SW Reg. DDC	MOS	N E	200 DSX	±20 O	22 D	125	100n	20		1m	200	2.1	4	VGS	10m	9	13	25	11			
2SK617	松下	RF PA, SW	MOS	N E	800 DSS	±20 S	1 D	40	1μ	20		0.1m	640	1	5	25	1m	0.4	0.65	25	700m			
2SK618	東芝	V/UHF LN A	GaAs	N D	10 DSX	-6 O	80m D	150m	-20μ	-5	20m	80m	5		-4	5	100μ		19m	5	10m			
2SK619	日立	RF A. ビデオ出力	MOS	N E	70 DSS	-6 O	300m D	1				1m	50	0.3	1.8	20	1m	90m	130m	10	200m			
2SK620	松下	SW	MOS	N E	50 DSS	8 O	100m D	150m	50m	8		10μ	10	1.5	3.5	VGS	100μ	20m		5	20m			
2SK621	松下	SW	MOS	N E	20 DS	8 O	100m D	150m	80μ	8		10μ	10	1.5	3.5	VGS	100μ	20m		5	20m			
2SK622	日立	HS PSW	MOS	N E	150 DSS	±20 S	20 D	120	±10μ	±16		0.25m	120	2	4	10	1m	9	15	10	10			
2SK623	日立	HS PSW	MOS	N E	250 DSS	±20 S	20 D	120	±10μ	±16		0.25m	200	2	4	10	1m	7	12	10	10			
2SK624	松下	LF Imp-C	J	N D	-20 GDO		2m G	200m				95μ	385μ	4.5				0.7m	1.6m	4.5	IDSS			
2SK625	東芝	C-MIC, Imp-C	J	N D	-20 GDO		10m G	100m	-50m	-10	0.06m	0.5m	5	-0.15	-0.8	5	0.1μ	0.5m	2m	5	IDSS			
2SK626	松下	RF PA, SW	MOS	N E	30 DSS		20 D	80	1μ	20		0.1m	25	1	5	10	1m	4.5	8	10	10			
2SK627	松下	RF PA, SW	MOS	N E	50 DSS		20 D	80	1μ	20		0.1m	40	1	5	10	1m	4.5	8	10	10			
2SK628	松下	RF PA, SW	MOS	N E	100 DSS		5 D	40	1μ	20		0.1m	80	1	5	10	1m	0.7	1.5	10	3			
2SK629	松下	RF PA, SW	MOS	N E	100 DSS		20 D	80	1μ	20		0.1m	80					3	7	10	5			
2SK630	松下	RF PA, SW	MOS	N E	160 DSS		5 D	40	1μ	20		0.1m	130	1	5	10	1m	0.7	1.5	10	3			
2SK631	松下	RF PA, SW	MOS	N E	160 DSS		10 D	80	1μ	20		0.1m	130	1	5	10	1m	2	6	10	5			
2SK632	松下	RF PA, SW	MOS	N E	200 DSS		5 D	40	1μ	20		0.1m	160	1	5	10	1m	0.7	1.5	10	3			
2SK633	松下	RF PA, SW	MOS	N E	200 DSS		10 D	80	1μ	20		0.1m	160					3	6	10	5			
2SK634	松下	RF PA, SW	MOS	N E	400 DSS		10 D	80	1μ	20		0.1m	320	1	5	25	1m	2	3.5	25	5			
2SK635	松下	RF PA, SW	MOS	N E	500 DSS		3 D	40	1μ	20		0.1m	400	1	5	25	1m	0.7	1.3	25	2			
2SK636	松下	RF PA, SW	MOS	N E	500 DSS		8 D	80	1μ	20		0.1m	400	1	5	25	1m	2.5	3.5	25	5			
2SK637	松下	RF PA, SW	MOS	N E	500 DSS		10 D	80	1μ	20		0.1m	400	1	5	25	1m	2	3.5	25	5			
2SK638	松下	RF PA, SW	MOS	N E	800 DSS		3 D	80	1μ	20		0.1m	640	1	5	25	1m	0.7	1.3	25				
2SK641	日立	HS PSW	MOS	N E	450 DSS	±15 S	10 D	100	±10μ	±12		0.25m	360	2	4	10	1m	4	7	10	5			
2SK642	日立	HS PSW	MOS	N E	500 DSS	±15 S	10 D	100	±10μ	±12		0.25m	400	2	4	10	1m	4	7	10	5			
2SK643	東芝	HS SW, DDC	MOS	N E	450 DSX	±20 S	10 D	125	±100m	±20		0.3m	450	2	4	10	1m	3	6	10	5			
2SK644	東芝	HS SW, DDC	MOS	N E	500 DSX	±20 S	10 D	125	±100m	±20		0.3m	500	2	4	10	1m	3	6	10	5			
2SK645	東芝	C-MIC, Imp-C	J	N D	-15 GDO		10m G	100m				100μ	315μ											
2SK646	日立	HS PSW, Hout	MOS	N E	1200 DSS	±20 S	4 D	125	±1μ	±20		1m	960	1	5	10	1m	0.7	1.3	20	2			
2SK647	松下	RF LN A	SB	N D	-6 GDO	-6 O	120m D	270m	-10μ	-3	20m	120m	3	-0.5	-3.5	3	100μ	20m	50m	3	10m			

電 気 的 特 性 (Ta=25℃)											コンブリ メンタリ	外 形	備 考	型 名	
Cis (typ) (pF)	Crs (typ) (pF)	V _{GS} (V)	V _{DS} (V)	NF typ dB	NF max dB	f (Hz)	R _G (Ω)	R _{DS(ON)} (max) (Ω)	V _{GS} (V)	I _D (A)					その他特性
1500	200	0	25					0.12	10	11			186	GDS	2SK616
350			20					8	15	1				代替2SK808	2SK617
1	0.06		5	1.2	2.5	1G					PG=19dBtyp	f=1GHz	105C	DGS	2SK618
10		0	10								V _{DS(ON)} =5Vmax	I _D =0.1A, V _{GS} =9V	136B	DSG	2SK619
15max	1max	0	5					50	5	20m	ton=10ns, toff=20nstyp	VDD=5V, RD=200Ω	193B	GSD	2SK620
								50	5	20m	ton=toff=1μsmax	VDD=5V, RD=200Ω	193B	GSD	2SK621
2200	220	0	10					0.075	10	10			149	GDS	2SK622
2000	270	0	10					0.15	10	10			149	GDS	2SK623
											NV=4μVmax	VD=4.5V, RD=2.2kΩ, A _β -β	192B	DGS	2SK624
7.2	2.3	0	5								VN=40mVmax	Av=80dB, IHP71M ²	105A	DSG	2SK625
1900	500max		10					0.07	15	10			191	GDS, 代替2SK1033	2SK626
1900	500max		10					0.07	15	10			191	GDS, 代替2SK1033	2SK627
500	120max		10					0.4	15	3			190	GDS, 代替2SK1260	2SK628
1900	250max		10					0.1	15	5			191	GDS, 代替2SK1262	2SK629
500	120max		10					0.5	15	3			191	GDS, 代替2SK1265	2SK630
1900	200max		10					0.2	15	5			191	GDS, 代替2SK1035	2SK631
500	100max		10					1.2	15	3			191	GDS, 代替2SK755	2SK632
1900	150max		10					0.25	15	5			191	GDS, 代替2SK757	2SK633
700	200max		20					0.7	15	5			191	GDS, 代替2SK765	2SK634
250	100max	0	20					4.5	15	2			191	GDS, 代替2SK766	2SK635
1000	100max		20					1.4	15	5			191	GDS, 代替2SK769	2SK636
700	200max		20					0.8	15	5			191	GDS, 代替2SK769	2SK637
550			20					5	15	3			196	GDS, 代替2SK796	2SK638
1300	65	0	10					0.8	10	5			149	GDS	2SK641
1300	65	0	10					1	10	5			149	GDS	2SK642
1350	260	0	10					0.8	10	5			184	GDS	2SK643
1350	260	0	10					1	10	5			184	GDS	2SK644
											Zin=200MΩmin, THD=4%max	VDD=2V, RL=1kΩ	155	DGS	2SK645
2000	130	0	10								V _{DS(ON)} =8Vmax	ID=2A, V _{GS} =15V	28B	GSD	2SK646
0.7		-6	3	1.8	12G								209	DSGS	2SK647